سیویلیکا - ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها
گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا
CIVILICA.com

عنوان مقاله:
شبیه سازی با نرم افزار ISE-TCAD و طراحی یک نوع SOI Mosfet جهت بهبودپارامتر DIBL

محل انتشار:
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:
صمد قلندری - *کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه*

آرش احمدی - *استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه*

خلاصه مقاله:
در این مقاله یک ساختار جدید برای ترانزیستور FD SOI Mosfet به منظور بهبود پارامتر DIBL و همچنین بهبود اثر خودگرمایی ارائه شده است.ایده اصلی این ساختار تغییر در ضخامت لایه Box ترانزیستور که به منظور بهبود پارامتر DIBL و اثر خودگرمایی می باشد.

کلمات کلیدی:
اثر خودگرمایی- FD SOI Mosfet - DIBL

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:
https://civilica.com/doc/386998